(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号

特開平11-204529 (43)公開日 平成11年(1999)7月30日

	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				
(51) Int.Cl. ⁸		裁別記号	FΙ		
H01L	21/3205		H01L	21/88	В
B41J	2/01		B41J	3/04	101Z

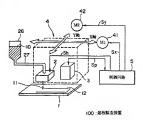
審査請求 未請求 請求項の数38 OL (全 16 頁)

(21)出顧番号	特顯平10-8016	(71) 出願人 000002369
		セイコーエプソン株式会社
(22)出職日	平成10年(1998) 1 月19日	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者 木口 浩史
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ: ーエプソン株式会社内
		(72)発明者 下田 達也
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ: ーエプソン株式会社内
		(72)発明者 福島 均
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ: ーエプソン株式会社内
		(74)代理人 弁理士 錦木 喜三郎 (外2名)
		品終百!*##

(54) 【発明の名称】 バターン形成方法および基板製造装置

(57)【要約】 【課題】 インクジェット方式を使用して基板にパター ン形成を可能とする基板の製造技術を提供する。

【解決手段】 流動体11により基板1上に任意のパター ンを形成するための基板製造装置に関する。当該装置 は、流動体11を基板1上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録ヘッド2、基板1上に一定の処理を行う 処理手段3、インクジェット式記録ヘッド2および処理手 談3と基板1との相対位置を変更可能に構成される影動手 段4、およびインクジェット式記録ヘッド2からの流動体 11の吐出、処理手段3による処理並びに駆動手段4による 駆動を制御する制御手段5を備える。制御手段5は、処理 手段による処理をインクジェット式記録ペッド2からの 流動体の吐出に先行して行わせることが可能に構成され ъ.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 旋動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記権動体の吐出前に予め前記基板上に一定の処理を行 うステップと、

前記処理をした基板上に前記インクジェット式記録ヘッ ドより前記旋動体を吐出するステップと、を備えたこと を特徴とするパターン形成方法。

流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基 板上に吐出するステップと、

前記流動体が吐出された前記基板に一定の処理を行うス テップと、を備えたことを特徴とするパターン形成方

【請求項3】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を吐 出するステップと、

前配インクジェット式記録ヘッドより吐出された液動体 が前記基板に到達する前までに、当該吐出された流動体 の液糖に一定の処理を行うステップと、を備えたことを 特徴とするパターン形成方法。

【請求項4】 前記処理は、前記補助体に化学的作用を 及ぼす処理である請求項1乃至請求項3のいずれか一項 に記載のパターン形成方法。

物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる処理で ある請求項1または請求項2に記載のパターン形成方

【請求項6】 前記処理は、前記流動体に化学反応を生 じさせる物質を前記基板に吐出する処理である請求項1 または請求項2に記載のパターン形成方法。

【諸求項7】 前記処理は、前記流動体に物理的作用を 及ぼす処理である請求項1万至請求項3のいずれか一項 に記載のパターン形成方法。

界に沿って吐出された前記流動体の境界を整形する処理 である請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項9】 前記処理は、前記パターン形成領域に沿 って吸収体を移動させることにより、満剰な前記流動体 を前記級収体に吸収させる処理である請求項2に記載の パターン形成方法。

【請求項10】 前記処理は、前記流動体に物理化学的 作用を及ぼす処理である請求項1乃至請求項3のいずれ か一項に記載のバターン形成方法。

一ン形成領域の周囲を前記添動体に対し非規制性に表面 改質する処理である請求項1に記載のパターン形成方

【請求項12】 前記処理は、前記基板のうち前記パク ーン形成領域を前記流動体に対し親和性に表面改質する

処理である請求項1に記載のバターン形成方法。 【請求項13】 前記処理は、前記基板のうち前記パタ ーン形成領域を、前記流動体を吸収する吸収層に表面改 賞する処理である請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項2】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 10 【請求項14】 前記処理は、前記パターン形成領域の 周囲に前記流動体が流出することを防止するためのパン クを形成する処理であって、

> 前記パターンの形成後当該パンクを除去する工程をおら に備える請求項2に記載のバターン形成方法。

> 【請求項15】 前配処理は、既に前紀潔新体が吐出さ れている前記パターン領域に沿ってさらに同一の流動体 を吐出する処理である請求項2に記載のバターン形成力

【請求項16】 前記処理は、前記液滴にエネルギーを 20 供給し、当該流動体の濃度を上昇させる処理である請求 項3に記載のパターン形成方法。

【請求項17】 前配処理は、前記被濁にエネルギーを 供給し、当該液滴の軌道を曲げる処理である請求項3に 配載のパターン形成方法。

【請求項18】 前記処理は、前記流動体に化学反応を 生じさせる物質を、前記液滴に作用させる処理である精 求項3に記載のパターン形成方法。

【請求項19】 前記処理は、前記液藻の薬性を検出す る気斑であって

【請求項5】 前記処理は、前記流動体に含まれる所定 30 検出された前記液滴の凝性に基づいて、前記インクジェ ット式記録ヘッドからの前記液滴の吐出を制御するステ ップをさらに備える請求項3に記載のパターン形成方 批

> 【請求項20】 所定の流動体により基板上に任意のパ ターンを形成するための基板製造装置であって、 前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク

ジェット式記録ヘッドと、 前記基板上に一定の処理を行う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理予設と 【請求項8】 前記処理は、前記パターン形成領域の境 40 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手設 ٤.

> 前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐 出、前記処理手段による前記処理並びに前距駆動手段に よる駆動を制御する制御手段と、を備え、

> 前記制御手段は、前記処理手段による処理を前記インク ジェット式記録ヘッドかちの流動体の吐出に先行して行 わせることが可能に構成された基板製造装置。

【請求項21】 所定の流動体により基板上に任意のパ ターンを形成するための基板製造装置であって

【請求項11】 前記処理は、前記基板のうち前記パタ 50 前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク

ジェット式記録ヘッドと、 前記基板上に一定の処理を行う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の社 出、前紀処理年時による前紀気弾並びに前空収録主路に

よる駆動を制御する制御手段と、を備え、 前記制御平鍛は、前記インクジェット式記録ヘッドから の流動体の吐出を処理手段による処理に先行して行わせ 10 面改賞することが可能に構成される請求20に記載のパ

ることが可能に構成された基板製造装置。 【請求項22】 所定の流動体により基板上に任意のパ

ターンを形成するための基板製造装置であって、 前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク ジェット次記録へッドと、

前記インクジェット式配録ヘッドから叶出された流動体 の液滴が基板に到達する輸に当該液滴に一定の処理を行 う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段 20 前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐 出、前記処理手段による前記処理並びに前記駆動手段に よる駆動を制御する制御手段と、を備えたことを特徴と する基板製造装置。

【請求項23】 前記処理手段は、前記流動体に化学的 作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20乃至請 水項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項24】 前記処理手段は、前記流動体に含まれ る所定物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる 30 【請求項35】 前記処理手段は、前記被額にエネルギ ことが可能に構成される請求項20または請求項21に 記載の基板製造装置。

【請求項25】 前記処理爭設は、前記流動体に化學反 応を生じさせる物質を前配基板に吐出することが可能に 構成される請求項20または請求項21に記載の基板製

【請求項26】 前記処理手段は、前記流動体に物理的 作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万至請 求項22のいずれか…項に記載の基板製造装置。

【請求項27】 前記処理手段は、前記パターン形成領 40 出する可能に構成され、 域の境界に沿って吐出された前記流動体の境界を整形可 能に構成される請求項21に記載の基板製造装置。

【請求項28】 前記処理予段は吸収体を備え、前記制 御手段は前記パターン形成頻域に沿って崩記吸収体を相 対的に移動させることにより、過剰な前記流動体を前記 吸収体に吸収させる請求項21に記載の基板製造装置。 【請求項29】 前記処理手段は、前記流動体に物理化 学的作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万 至請木項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項30】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 50 する。

パターン形成領域の周囲を前記流動体に対し、非銀和性に 表面改質することが可能に構成される請求項20に記載 の基板製造装置。

【請求項31】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 パターン形成領域を前記流動体に対し親和性に表面改賞 することが可能に構成される請求項20に記載の基板制 造装置。

【請求項32】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 パターン形成領域を、前記流動体を吸収する吸収器に表 ターン形成方法。

【請求項33】 前記処理手段は、前記パターン形成領 域の周囲に前記流動体が流出することを防止するための パンクを形成可能に構成され、

当該製造装置は、前記パターンの形成後当該パンクを除 去する手段をさらに備える請求項22に記載の茘板製造

【請求項34】 所定の流動体により基板上に任意のバ ターンを形成するための基板製造装置であって、

ジェット式記録ヘッドと、

前記インクジェット式記録ヘッドと前記基板上との相対 位置を変更可能に構成される駆動手段と、

前記インクジェット式配録ヘッドからの前記流動体の計 出および前記駆動手段による駆動を制御する制御手段

前記制御手段は、既に前記流動体が吐出されている前記 パターン領域に沿って前記インクジェット式記録ヘッド からさらに開一の流動体を吐出する基板製造装置。

一を供給し、当該流動体の濃度を上昇させることが可能 に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項36】 前記処理手段は、前記被衡にエネルギ 一を供給し、当該液滴の軌道を曲げることが可能に構成 される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項37】 前記処理手段は、前記流動体に化学反 応を生じさせる物質を、前記液滴に供給可能に構成され る請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項38】 前記処理手段は、前記被適の属性を検

前記制御手段は、前記処理手段により検出された前針被 適の属性に基づいて、前記インクジェット式記録ヘッド からの前記波滴の吐出および前記駆動手段による駆動を 制御する請求項22に記載の某板製造装置。

【発明の詳細な説明】 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェット式記 録ヘッドの工業的応用に係り、特にインクジェット方式 によって任意のパターンを形成するための製造技術に期

[00021

【従来の技術】半導体プロセス等で用いる基板はシリコ ン等で構成されている。従来、当該シリコン基板から集 積回路等を製造するために、リソグラフィー法等が使用 されていた。

【0003】このリソグラフィー独は、シリコンウェハ 上にレジストと呼ばれる磁光材を薄く塗布し、ガラス乾 板に写真製版で作成した集積回路パターンを光で焼き付 けて転写する点である。転写されたレジストバターンに イオン等を打ち込んで、配線パターンや素子を形成して 10 いくものであった。

【0004】上記リソグラフィー法を用いるには、写真 製版、レジスト途布、麟光、現像等の工程を必要として いたため、設備の整った半導体工場等でなければ微緩バ ターンの作成ができなかった。このため微細パターンの 形成は、複雑な工程管理とコストを要するのが常識であ

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、超LSIほ どの微細パターンまではいかなくても、µmのオーダー 20 のパターンを簡単に、しかも安価にかつ工場等の設備を 用いることなく、製造することができるものとすれば、 工業的に無限の需要が考えられる。

【0006】ところで、出版人は用紙に印字する技術と してインクジェット方式に技術的蓄積がある。インクジ エット方式ではインクを吐出させるためにインクジェッ ト式記録ヘッドを使用する。このヘッドはインクをノズ ル穴から吐出可能に構成され、ノズル穴からインクを用 紙上に吐出することによって印字を行うものであった。 的とするプリンタに用いられてきた。

【0007】インクジェット式記録ヘッドは粘性が低い 流動体であれば任意の流動体を駐出可能である。しかも このインクジェット式記録ヘッドの解像度は、例えば4 00bpiと微細である。このためインクジェット式記 緑ヘッドの個々のノズル穴から工業的用途に使える流動 体を吐出できれば、umオーダーの幅で任意のパターン が形成できると考えられる。インクジェット方式によれ ば、工場のような設備を必要としない。

体をパターンとして定着させるための関連処理が必要に なるため、インクジェット式記録ヘッドから流動体を計 出可能に構成するのみではパターンを形成することがで きない。例えば、基板にバターンを定着させるために は、流動体から工業材料を出現させるための化学的処 理、パターンの形を整えるための物理的処理、あるいは パターン形成領域にパターン材料を正しく定着させるた めの物理化学的処理が必要になる。

【0009】ただし流動体に対して処理をするとはいっ

ーンを形成することを目的としたインクジェット方式に よる基板製造の利点が生かせない。

[0010]

【課題を解決するための手段】そこで、本願発明者はイ ンクジェット方式によってパターン形成を行うにあた り、インクジェット式記録ヘッドの前後またはヘッドか ら吐出された瞬間に、パターン形成に必要な処理を完遂 させる技術を考察した。

【0011】すなわち本発明の第1の課題は、基板上に 流動体が吐出される前に処理可能とすることによりバタ ーンを形成可能とする方法およびその製造装置を提供す ることである.

【0012】本発明の第2の課題は、基板上に流動体が 叶出された後に処理可能とすることによりバターンを形 成可能とする方法およびその製造装置を提供することで ある.

【0013】本発明の第3の課題は、流動体が吐出され た瞬間に処理可能とすることによりパターンを形成可能 とする方法およびその製造装置を提供することである。 【0014】上記第1の課題を解決する発明は、インク ジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基板上に吐出 して任意のパターンを形成するパターン形成方法であっ て、前記流動体の吐出前に予め前記基板上に一定の処理 を行うステップと、前記処理をした基板上に前記インク ジェット式記録ヘッドより前記流動体を吐出するステッ ブと、を備える。

【0015】ここで、流動体とはインクのみならず工業 的用途に用いることができ、ノズルから吐出可能な粘度 を備えた媒体をいう。水性であると油性であるとを聞わ いままでインクジェット方式の応用は主として印字を目 30 ない。ノズル等から吐出可能な流動性(粘度)を備えて いれば十分で、個体物質が混入していても全体として流 動体であればよい。インクジェット式記録ヘッドは、圧 電体素子の体積変化により流動体を吐出させる方式であ っても、熱の印加により急激に蒸気が発生することによ り流動体を吐出させる方式であってもよい。一定の処理 とは、化学的処理でも、物理的処理でも、物理化学的処 理でもよい。これら定義は以下同様に用いる。

【0016】上記第2の課題を解決する発明は、インク ジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基板上に吐出 【0008】しかし流動体によるパターン形成には流動 40 して任意のパターンを形成するパターン形成方法であっ て、インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基 板上に吐出するステップと、流動体が吐出された基板に 一定の処理を行うステップと、を備える。

【0017】上記第3の課題を解決する発明は、インク ジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基板上に吐出 して任意のパターンを形成するパターン形成方法であっ て、インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を吐 出するステップと、インクジェット式記録ヘッドより吐 出された流動体が基板に到達する前までに、当該吐出さ て、大がかりな製造装置を使用するのでは、平軽にパタ 50 れた流動体の液滴に一定の処理を行うステップと、を輸 28.

【0018】例えば上記処理は、流動体に化学的作用を 及ぼす処理である。化学的作用とは、物質に折出や化学 反応等をいう。例えばこの処理は、流動体に含まれる所 定物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる処理 である。この処理は、例えば熱風吹き付け、レーザ照 射、ランプ照射、減圧、雰囲気変化(温度およびミス

ト)を基板または流動体に与えることにより得られるも のである。またこの処理は、流動体に化学反応を生じさ せる物質を基板に吐出する処理である。またこの処理 は、液器にエネルギーを供給し、当該流動体の濃度を上 料させる処理である。さらにこの処理は、披露にエネル ギーを供給し、当該液液の軌道を曲げる処理である。

【0019】例えば上記処理は、遊動体に物理的作用を 及ぼす処理である。物理的作用とは、流動体に力学的、 電気学的、磁気学的な影響を及ぼすことをいう。この処 理は、例えば、パターン形成領域の境界に沿って吐出さ れた流動体の境界を整形する処理である。またこの処理 は、パターン形成領域に沿って吸収体を移動させること により、過剰な流動体を吸収体に吸収させる処理であ

【0020】例えば上記処理は、流動体に物理化学的作 用を及ぼす処理である。物理化学的処理とは、物理的作 用と化学的作用の相互から流動体の挙動に影響を与える ことをいう。この処理は、例えば基板のうちパターン形 成領域の周囲を流動体に対し非親和性に表面改質する処 理である。またこの処理は、薬板のうちパターン形成領 域を流動体に対し親和性に表面改造する処理である。こ こで非親和性とは、流動体に対する相対的に接触角が大 さい性質をいう。親和性とは、流動体に対する接触角が 30 相対的に小さいことをいう。これらの表現は、流動体に 対する膜の挙動を明らかにするために、親和性と対比し て用いられるものである。この処理は、拡板のうちパタ ーン形成領域を、流動体を吸収する吸収層に表面改質す る処理である。さらにこの処理は、パターン形成領域の 悶囲に流動体が流出することを防止するためのパンクを 形成する処理であり、パターンの形成後当該バンクを除 去する工程をさらに備える。さらにまたこの処理は、既 に流動体が吐出されているパターン領域に沿ってさらに 向…の流動体を吐出する処理である。さらにまたこの処 40 理は、流動体に化学反応を生じさせる物質を、液滴に作 用させる処理である。また、この処理は、波線の属性を 検出する処理であって、検出された液滴の属性に基づい て、インクジェット式記録ヘッドからの液滴の吐出を解 御するステップをさらに備える。

【0021】本発明は、所定の流動体により基板上に任 意のバターンを形成するための基板製造装置であって、 流動体を基板上に吐出可能に構成されたインクジェット 式記録ヘッドと、基板上に一定の処理を行う処理手段

との相対位置を変更可能に構成される駆動手段と、イン クジェット式記録ヘッドからの流動体の時出、処理手段 による処理および駆動手段による駆動を制御する制御手 段と、を備える。そして制御手段は、処理手段による処 理をインクジェット式記録ヘッドからの流動体の吐出に 先行して行わせることが可能に構成される。

【0022】また本発明は、所定の流動体により基板上 に任意のパターンを形成するための基板製造装置であっ て、流動体を基板上に吐出可能に構成されたインクジェ 10 ット式記録ヘッドと、基板上に一定の処理を行う処理手 段と、インクジェット式記録ヘッドおよび処理手段と基 板との相対位置を変更可能に構成される影動手段と、イ ンクジェット式記録ヘッドからの流動体の社出、処理手 段による処理および駆動手段による駆動を制御する制御 平段と、を構える。そして制御手段は、インクジェット 式記録ヘッドからの流動体の吐出を処理手段による処理 に先行して行わせることが可能に構成される。

【0023】本発明は、廃定の流動体により基板上に任 意のパターンを形成するための基板製造装置であって、 20 流動体を基板上に吐出可能に構成されたインクジェット 式記録ヘッドと、インクジェット式記録ヘッドから叶出 された流動体の液滴が基板に到達する前に当該液滴に---定の処理を行う処理手段と、インクジェット式配録へッ ドおよび処理手段と基板との相対位置を変更可能に構成 される駆動手段と、インクジェット式記録ヘッドからの 流動体の吐出、処理手段による処理および駆動手段によ る駆動を制御する制御手段と、を備える。

【0024】例えば上記処理手段は、流動体に化学的作 用を及ぼすことが可能に構成される。

【0025】また処理手段は、流動体に含まれる所定物 質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させることが可 能に構成される。

【0026】さらに処理手段は、流動体に化学反応を生 じさせる物質を基板に吐出することが可能に構成され

【0027】さらにまた処理手段は、流動体に物理的作 用を及ぼすことが可能に構成される。

【0028】また理手段は、パターン形成領域の境界に 沿って吐出された流動体の境界を整形可能に構成され Z.

【0029】さらに処理手段は吸収体を備え、制御手段 はパターン形成領域に沿って吸収体を相対的に移動させ ることにより、過剰な流動体を吸収体に吸収させる。 【0030】さらにまた処理手段は、流動体に物理化学 的作用を及ぼすことが可能に構成される。

【0031】また処理手段は、基板のうちバターン形成 領域の周囲を流動体に対し非親和性に表面改質すること が可能に構成される。非親和性とは、流動体に対する相 対的に接触角が大きい性質をいう。この表現は、流動体 と、インクジェット式記録ヘッドおよび処理手段と基板 50 に対する膜の挙動を明らかにするために、銀和件と対比

して用いられるものである。

【0032】さらに処理手段は、基板のうちバターン形 成領域を流動体に対し親和性に表面改領することが可能 に構成される。ここで、親和性とは、流動体に対する接 触角が相対的に小さいことをいう。

【0033】さらに処理手段は、基板のうちパターン形 成領域を、流動体を吸収する吸収層に表面改賞すること が可能に構成される。

【0034】さらにまた処理手段は、バターン形成領域 の周囲に拡動体が微出することを防止するためのパンク 10 れた圧力重基板22を、筒体25に嵌め込んで構成され を形成可能に構成され、当該製造装置は、パターンの形 成後当該パンクを除去する手段をさらに備える。

【0035】本発明は、所定の流動体により基板上に任 意のパターンを形成するための基板製造装置であって、 流動体を拡板上に吐出可能に構成されたインクジェット 式記録ヘッドと、インクジェット式記録ヘッドと基板ト との相対位置を変更可能に構成される駆動手段と、イン クジェット式記録ヘッドからの流動体の吐出および駆動 手段による駆動を制御する制御手段と、を備える。そし 域に沿ってインクジェット式記録ヘッドからさらに筒ー の流動体を吐出する。

【0036】例えば処理手段は、液滴にエネルギーを供 給し、当該流動体の濃度を上昇させることが可能に構成 される。

【0037】また処理手段は、液滴にエネルギーを供給 し、当該液滴の軌道を曲げることが可能に構成される。 【0038】さらに処理手段は、流動体に化学反応を生 じさせる物質を、液滴に供給可能に構成される。

する可能に構成され、制御手段は、処理手段により輸出 された被摘の属性に基づいて、インクジェット式配鉄へ ッドからの液滴の吐出および駆動手段による駆動を制御 する。

[0040]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施するための掛 良の形態を、関面を参照して説明する。

【0041】 (共通構成) 図1に以下の各実施形態で用 いる基板製造装置の共通部分の概念構成図を示す。図1 ト式記録ペッド2、処理装置3、駆動機構4および制御 回路5を備えている。以下の各実施形態では、処理装置 3の配置と処理内容がそれぞれ異なり、残りの構成は各 実施形態にほぼ共通して使用される。

【0042】インクジェット式記録ヘッド2には、流動 体10が入れられたインクタンク26がパイプ27を介 して流動体10を供給可能に接続されている。流動体1 0としては、インクジェット式記録ヘッドから吐出可能 な流動性を呈するものならば、親水性であると非親水性 物全部が液状でなくともよい。例えば適當性を示す金属 を微粒子として溶剤中に混入させたものでもよい。

【0043】まずインタジェット式記録ヘッドの構造を 説明する。例18はインクジェット式記録ヘッド2の分 解斜視図である。インクジェット式記録ヘッド2は、… 般的なインクジェット式定録ヘッドとして任意の流動体 を吐出可能に構成されていれば十分である。 図18のイ ンクジェット式記録ヘッド2では、ノズル211の設け られたノズルブレート21、および援動板23の設けら

る。圧力監基板22は、例えばシリコンをエッチングし て形成され、キャビティ(圧力室) 221、側壁222 およびリザーパ223等が形成されている。

【0044】図19にノズルプレート21、圧力容基板 2 2 および振動板 2 3 を積緩して構成されるインクジェ ット式記録ヘッド2の主要部構造の斜提図一部断面図を 示す。同図に示すように、インクジェット武記録ヘッド 2の主要部は、圧力室基板22をノズルプレート21と 振動板23で挟み込んだ構造を備える。 ノズルブレート て制御手段は、既に流動体が吐出されているパターン領 20 21は、圧力返基板22と貼り合わせられたときにキャ ビディ221に対応する位置に配置されるように、ノズ ル穴211が形成されている。圧力室基板22には、シ リコン単結晶基板等をエッチングすることにより、各々 が圧力室として機能可能にキャビティ221が複数設け られる。キャビティ221間は側壁222で分離されて いる。各キャビティ221は、供給口224を介して比 通の流路であるリザーパ223に繋がっている。 振動板 23は、例えば熱酸化膜等により構成される。 振動板 2 3上のキャピティ221に相当する位置には、圧電体器 【0039】さらにまた処理手段は、液滴の属性を検出 30 子24が形成されている。また、振動板23にはインク タンクロ231が設けられ、タンク26から任意の推動

> 体10を供給可能に構成されている。圧雷体素子24 は、例えばPZT素子等を上部電機および下部電板(図 示せず)とで挟んだ構造を備える。圧電体案子24は、 制御回路5から供給される制御信号Shに対応して伝路 変化を生ずることが可能に構成されている。

【0045】なお上配インクジェット式配録ヘッドは圧 電体素子に体積変化を生じさせて流動体を吐出させる構 成であったが、発熱体により流動体に熱を加えその膨張 に示すように、本薬板製造装置100は、インクジェッ 40 によって液滴を吐出させるようなヘッド構成であっても よい.

> 【0046】処理装置3は、基板1に対して所定の処理 を施すことが可能に構成されている。 処理装置 3 は無額 回路5から供給される制御信号Spに対応して処理を行 う。処理装置3の機能、構造に関しては、以下の各実施 形態で明らかにする。

【0047】駆動機構 4は、モータM1、モータM2お よび図示しない機構構造を備えており、インクジェット 式記録ヘッド2および処理装置3をともに、X総方向 であるとを問わずあらゆるものが適用可能である。構成 50 (図1の横方向)およびY軸方向(図1の奥行き方向)

る..

に搬送可能に構成されている。モータM1は駆動信号S xに応じてインクジェット式記録ヘッド2および処理装 置3をX軸方向に搬送可能に構成される。モータM2は 駆動信号Syに応じてインクジェット式記録ヘッド2お よび処理装置をY軸方向に搬送可能に構成される。

【0048】 なお、駆動機構 4 は基板 1 に対するインク ジェット式記録ヘッド2および処理装置3の位置を相対 的に変化可能な構成を備えていれば十分である。このた め上記構成の他に、基板1がインクジェット式記録へっ ジェット式記録ヘッド2および処理装置3と、基板1と がともに動くものであってもよい。また、処理の形態に よっては処理装置3がインクジェット式配録ヘッド2と ともに搬送される必要はなく、処理装置3が影像に搬送 されても、静止しているものであってもよい。

【0049】 図21を参照してインクジェット式記録へ ッド2の吐出原理を示す。園園は図20のA-Aの絵に おける断面図である。流動体10は、タンク26から、 振動板23に設けられたインクタンクロ231を介して リザーバ223内に供給される。流動体10は、このリ 20 ザーバ223から供給口224を通して各キャビティ2 21に流入する。圧電体素子24は、その上部電極と下 部艦機との間に電圧を加えるとその体積が変化する。こ の体積変化が振動板23を変形させ、キャビティ21の 体積を変化させる。

【0050】制御僧号Shが供給されず、竜圧を加えな い状態では振動板23の変形がない。樹御信号Shが供 給され電圧が加えられると、同図の破線で示す位置まで 振動板23bや変形後24bの圧電素子が変形する。キ ャビティ21内の体積が変化すると、キャビティ21に 30 れる。 満たされた流動体10の圧力が高まる。ノズル穴211 には流動体12が供給され、液滴11が吐出される。

【0051】(配置の態機)図2乃至図4を参編して本 発明の基本的な処理の配置をそれぞれ説明する。本様明 はインクジェット式記録ヘッドから吐出された流動体に 行う処理装置の配置を3つに区別して考える。

【0052】図2はインクジェット式記録ヘッドから流 動体を吐出する前に基板に対して処理を行う第1の配置 の概念図である。祠図に示すように、インクジェット式 配餘ヘッド2および処理装置3は矢印搬送方向に相対的 40 に頻送される。第1の配置の場合、処理装置3は進行方 向に対してインクジェット式記録ヘッド2より前に配置 される。そして基板1に対しインクジェット式記録へッ ド2から流動体の被摘11が吐出される前に基板1に対 して所定の処理7を行うものである。処理の詳細は以下 の実施形態で説明する。

【0053】図3はインクジェット式記録ヘッドから流 動体を吐出した後に流動体または基板に対して処理を行 う第2の配置の概念図である。同図に示すように、イン クジェット式記録ヘッド2および処理装置3は矢印搬送 50 【0059】後処理を行う第2の配置で上記処理装置3

方向に相対的に翻送される。第2の配置の場合、処理等 置3は進行方向に対してインクジェット式記録ヘッド2 より後に配置される。そしてインクジェット式記録へっ ド2から基板1に対し流動体の波滴11が吐出された後 に基板1に対して所定の処理7を行うものである。処理 の詳細は以下の実施形態で説明する。

【0054】図4はインクジェット式記録ヘッドから吐 出された流動体の液滴に直接処理を行う第3の配置の概 念図である。第3の配置の場合、処理装置3はインクジ ド2や処理装置3に対して動くものであっても、インク 10 ェット式記録ヘッド2から吐出された液滴11に対して 直接処理可能に配置される。そしてインクジェット式記 録ヘッド2から吐出された流動体の液滴11が基板1に 到達する前に、当該液滴11に対して所定の処理7を行 うものである。処理の詳細は以下の実施形態で説明す

> 【0055】 (実施形態1) 本発明の実施形態1は化学 的作用(溶解度低下)を流動体に及ぼす処理に関し、主 に上記第1の配置および第2の配置において用いられ

> 【0056】図5に本実施形態1の処理概念を説明する 側面図を示す。本実施形態1の処理装置301は、流動 体11が吐出される前の基板1に対して、流動体に混入 している物質の溶解度を低下させ、その細形分を折出さ せる処理701を適用可能に構成されている。このよう な処理として、熱風の吹き付け、レーザ照射、ランプ照 射等を行って流動体の溶媒成分を蒸発させるといった処 理が考えられる。同図は第1の配置に適用した構成を示 すが、第2の配置に適用した場合には処理装置301が インクジェット式記録ヘッド2の進行方向後方に配置さ

【0057】熟風の吹き付けを行う場合、処理装置30 1は空気を吹き付けるコンプレッサおよび空気を熱する ヒータ等を構える。レーザ照射を行う場合には、所定の 波長のレーザ光を照射するレーザ発光用ダイオード、レ 一ザ光を集光するためのレンズ群およびレンズ難を駆動 して適正にレーザ光を基板上に集光するためのアクチュ エータ装置等を備える。ランプ照射を行う場合は、キセ ノンランプ等の高エネルギーを放射可能なランプ、リフ レクタ、レンズ群等を備える。

【0058】前処理を行う第1の配置で上記処理装置3 01を用いる際、上記処理を流動体の液滴11が叶出さ れる直前の基板 1 に対して行う。基板に着弾した液流 は、すでに基板1が熱せられているので、差極直後から 溶媒成分が蒸発し、流動体が滯縮される結果として、因 形分が残留あるいは溶解物が析出するようになる。例え ば流動体が溶媒中に金属の微粒子を含んだものであれ ば、熱の影響で溶媒成分のみが蒸発し、金属微粒子を導 電性のパターンとして基板上に残留させることができ

0.1を用いる際、既に基板上に吐出された液動体の液滴 に対して上記処理を行う。同様の作用により溶解物を折 出させることができる。

【0060】なお、上記処理の他に、局所的に滅圧させ たり雰囲気を変更可能に構成してもよい。このように構 成すれば、遊動体に対する溶解物の溶解度を低下させ、 結果として溶解物を析出させることが可能となる。また 基板全体を熱する等の措置も本実施形態の一変形例に加 えられる。このためには基板1の載置台にヒータ装置等 を設けることになる。

【0061】上節のように本実施形態1によれば、エネ ルギーを加えることにより流動体から圏形物質を残留あ るいは析出させることができ、パターン形成が容易に行 える。また処理装置によって局所的に服熟するのみで済 むので、加熱設備が小さくて済み、消費エネルギーを低 く抑えることができる。

【0062】 (実施形態2) 本発明の実施形態3は化学 的作用(化学反応)を流動体に及ぼす処理に関し、主に 上記第1の配置および第2の配置において用いられる。 【0063】図6に本実施形態2の処理概念を説明する 側面図を示す。本実施形態2の処理装置302は、活動 体11が吐出される前の基板1に対して、流動体に対し 化学度応や分散器の破壊をしたらす反応減709を計出 可能に構成されている。処理装置302としてはインク ジェット式記録ヘッド2と同様な構成を用いることが好 ましい。流動体の液滴11とほぼ同量の反応液を影響し ながら吐出させることができるからである。 同図は第1 の配置に適用した場合の構成を示すが、第2の配置に適 用した場合には処理装置302がインクジェット式記録 ヘッド2の進行方向後方に配置される。

【0064】分散系の破壊をもたらす処理として、流動 体の液滴11がスチレン-アクリル樹脂により分散した 育機類料を主成分とする場合に、反応被702として請 酸マグネシウム水溶液を吐出する場合が挙げられる。ま た化学反応をもたらす処理として、流動体の液滴11が エポキシ樹脂を主成分とする場合に、反応液702とし てアミン類を吐出する場合が挙げられる。

【0065】前処理を行う第1の配置で上記処理装置3 02を用いる際、流動体の被摘11が吐出される前のパ ターン形成領域に対して上記反応被702を吐出する。 反応被702が吐出されたバターン形成領域上に該適1 1が着弾すると、分散系の破壊あるいは化学反応が生 じ、樹形物質13が折出する。例えば波滴11が金属塩 を含む場合、この塩と反応可能な反応被702を用いる ことにより、導能性のある金属パターンを形成できる。 【0066】後処理を行う第2の配置で上記処理装置3 を用いる際、既に基板上に吐出された流動体の液滴11 に対して反応被702を吐出する。同様の作用により個 形物質13を生成させることができる。

14 緑ヘッドを2個使用したが、さらに複雑な反応を生じさ

せるためには、他の反応液を吐出可能なヘッドを増やし ていけばよい。

【0068】上記したように実施形態2によれば、反応 液により分散系の破壊や化学反応を生じさせるので、イ ンクジェット式記録ヘッドを複数装備するだけでパター ンを形成できる。特に同様な構成のヘッドを複数設け、 そこから吐出させる物質のみを変えればよいので、製造 装置の設計が容易である。

10 【0069】 (実施形態3) 本発明の実施形態3は物理 化学的作用として基板の親和性を改善する処理に関し、 主に上記第1の配置において用いられる。

【0070】図7に本実施形能3の処理概念を説明する 平面図を示す。本実施形態4の処理装置303は、流動 体11が吐出される前の基板1のパターン形成領域を、 流動体に対し親和性を備えるように表面改賢可能に構成 されている。

【0071】親和性を備えるように装面改賞する処理と しては、流動体が極性分子を含む場合(太分を含む場合 20 等)は、シランカップリング剤を塗布する方法、酸化ア ルミニウムやシリカ等の多孔質膜を形成する方法、アル ゴン等で逆スパッタをかける方法、コロナ放電処理、プ ラズマ処理、紫外線照射処理、オゾン処理、脱脂処理 等、公知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を 含まない場合には、パラフィン等を塗布する方法、ガス プラズマ処理、カップリング処理等がある。

【0072】シランカップリング剤を用いる場合には、 処理装置303は、無機質と反応しやすいアルコキシ基 やハロゲンなどの加木分解性の置換基と有機質と反応し 30 やすいビニル基、エボキシ基、アミノ基等とをともに持 つ有機ケイ素化合物(シランカップリング剤)を塗布可 能に構成される。塗布方法としては、インクジェット式 配録ヘッドからの材料社出やボールペン類似の塗布機構 による直接物布が考えられる。多孔質額を形成する場合 には、処理装置303は多孔質材料、例えばA12O3や シリカを塗布可能に構成される。塗布方法は上配と同様 である。逆スパッタをかける方法の場合には、処理装置 303としてスパッタリング装置を適用する。 すなわち カソード、基板をアノードにする電極、アルゴン雰囲気

調整機構および電源等を備える。逆スパック処理によ り、基板の表面が活性化され、繋水性の置換基に置き換 わり、基板表面が改質される。コロナ放電を行う場合に は処理装置303として高電圧放電用電極を備え、基板 1に接地電圧を印加可能に構成する。基板を面に高電圧 が局所的に印加されることにより基板の有機分子の一部 が親水性のある基に置き換わり表面改質される。プラズ マ処理をするには、処理診暦303と1.で依依物能で生 じたプラズマを噴出可能に構成する。紫外線を照射する 場合には、処理装置303として紫外線照射用ランプを 【0067】なお上記実施形態ではインクジェット式記 50 備える。オブン処理を行う場合は、処理装置303とし てオブンの流通する雰囲気下で所定の電圧を印加し、活 性化したオゾンを基板に放出可能に構成する。脱脂処理 を行う場合には、処理装置303として、基板上に過せ ンガン酸、クロム酸、硫酸、硝酸等の強アルカリを供給 可能に構成する。パラフィン等を塗布する場合には、処 理装置303にボールペン類似の塗布機構を使用し、バ ターン形成領域の両辺を中心とする領域に溶解したパラ フィン等を塗布する。

【0073】上記処理装置303を備えたので、シラン カップリング剤を塗布した場合には、パターン形成領域 10 703に塗布されたシランカップリング剤が基板材料と 密着し、一方で水に対して濡れ易い基が表面に蔵出す る。多孔質膜を形成した場合には、パターン形成領域7 03に形成された酸化アルミやシリカ等の腺が多孔質で あるため流動体を含み易くなる。逆スパッタを行った場 合にはパターン形成領域の表領温度が上昇し際の付着力 を向上させたり親水性膜に変えたりできる。コロナ放置 を行った場合には、基板表面にOH基やCOOH基が生 成するため親水性を備えるようになる。ブラズマ処理を 行った場合、基板表面の高分子の未反応基と架構局を生 20 ずる。未反応基は容易に酸化され、OH基やC O基、 CHO基、COOH基等が発生し親水性を備えるように なる。ボリエステルやボリブロビレンを使用した基板等 に紫外線照射を行った場合、OH基やCOOH基を生成 して親水性を備える。ABSやポリプロピレン等にオゾ ン処理を行った場合には、表面の親和性が改善される。 脱胎処理を行った場合には、基板表面が酸化され親水性 の基に置換され親水性を示すようになる。パラフィン等 の絵布処理を行った場合には、絵布された伽域が非極性 性分子である場合に濡れ易くなる。

【0074】上記実施形態 3によれば、インクジェット 式記録ヘッド2からの流動体の吐出に先行して表面改管 されたパターン形成領域で03に親和性を示す談が形成 されるので、パターン形成領域に着弾した液滴12が広 がり過ぎたり分離したりするおそれが少なくなる。 【0075】 (実施形態4) 本発明の実施形態4は物理 化学的作用としてパターンの調倒に非規和件節減を設け る処理に関し、主に上記第1の配置において用いられ

【0076】図8に本実施形態4の処理概念を説明する 平面殴を示す。本実施形態4の処理装置304は、基板 1のパターン形成領域外側の仮域に流動体に対し非親和 性を示す膜704を形成可能に構成されている。

【0077】非親和性を示す線を形成する処理として は、流動体が極性分子を含む場合には上記したパラフィ ン等を塗布する方法等が挙げられる。流動体が極性分子 を含まない場合には、上記実施形態3で説明したシラン カップリング剤を塗布する方法、酸化アルミニウムやシ ッタをかける方法、コロナ放電処理、プラズマ処理、参 外線照射処理、オブン処理、脱脂処理等、公知の種々の 方法を適用する。

【0078】非極性分子に対し非親和性を示す機や、極 性分子に対し親和性を示す鏡の形成方法については上記 実施形態3と同様なので説明を省略する。

【0079】上記したように実施形態4によれば、イン クジェット式記録ヘッド2からの流動体の吐出に先行し でパターン形成領域の両側に流動体に対し非規和性を示 す終704が形成されるので、パターン形成領域からは み出た流動体は非親和性膜704ではじかれるため、流

動体をパターン形成領域に収めることができる。 【0080】(実施形態5) 本発明の実施形態5は物理 化学的作用としてパターン形成領域を、流動体を吸収可 能に形成に形成する処理に関し、主に上記第1の配置に おいて用いられる。

【0081】図9に本実施形態5の処瑕概念を説明する 側面図を示す。本実施影艦5の処理装置305は、装板 1のパターン形成領域に流動体を吸収する吸収層705 を形成可能に構成されている。

【0082】吸収層705としては、ポリビニルアルコ ール (PVA)、ポリ酢酸ビニル等を適用することが可 能である。ポリビニルアルコールの総布するために、処 理装置305はボールペン類似の塗布機構を備えること が考えられる。

【0083】上記構成において、処理装置305が流動 体の吐出に先行して吸収層705を形成し、形成された 吸収層705の上にインクジェット式記録ヘッド2から 流動体の液滴11が吐出される。吐出された流動体の液 分子に対し親和性を示すようになるため、流動体が非極 30 滴11のうち一部は吸収層705に吸収されて離14内 に流動体が定着する。このため吸収層を形成した領域に パターンが形成されることになる。

> 【0084】本実施形態5によれば、インクジェット式 記録ヘッド2からの流動体の引出に先行して処理装置3 0.5が吸収層を形成するので、吸収層の通りにパターン 形成が行え、過剰な流動体を吸収層に吸収させることが できる.

【0085】 (実施形態6) 本発明の実施形態6は物理 化学的作用としてパターン形成領域の境界付近に流動体 40 の流出を抑えるパンク (土手状のもの)を形成する処理 に関し、主に上記第1の配置において用いられる。

【0086】図10に本実施形態6の処理概念を説明す る平面図を示す。本実施影熊6の処理装置306は、私 板1のパターン形成節域の境界付近に流動体の流出を防 止するバンク706を複数形成可能に構成されている。 処理装置306としては、パンクの材料を一定の高さで 形成する必要があるため、ボールペン類似の塗布機構を 複数用いる。各塗布機構はパターン形成領域の幅方向に その幅だけ離れて配置される。バンク706の材料とし リカ等の多孔賞談を形成する方法、アルゴン等で逆スパ 50 ては、ポリイミド、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等が考

えられる。

【0087】上記構成において処理装置306は流動体 の吐出に先行してパンク70日を形成していく。パンク の形成後にバターン形成領域に流動体の被滴11が吐出 されるとパンク706が存在するためにパンク外に流動 体が流出していくことはない。流動体は二つのパンクに 洲まれたパターン形成領域内で紹化する.

【0088】なお、流動体が顕化した後にパンク706 を取り除く工程を設けることは好ましい。流動体がパタ ーンとして定着すればパンクは不要になるからである。 パンクの除去にはプラズマアッシング、エッチング等の 方法を用いる。

【0089】本実施形態6によれば、インクジェット式 配録ヘッドからの流動体の吐出に先行してパンクを形成 するので、流動体がパターン形成領域外に流出すること を防止できる。パターンの定着後にバンクを取り除け は、パターンの幅を狭く維持できる。

【0090】 (実施形態7) 本発明の実施形態7は物理 的作用として吐出された流動体を整形する処理に関し、 主に上記第2の配置において用いられる。

【0091】図11に本実施形能7の処理概念の説明図 を示す。(a)は平面図、(b)は側面図を示す。本実 施形態7の処理装置310は、基板1に着弾した流動体 12をパターン形成領域の境界に沿って擦る針状部材7 10を複数備えている。各針状態材710はパターン形 成領域の幅方向にその幅だけ離れて配置される。針状部 材710としては、一定の機械的強度がある一方、基板 に損傷を与えない程度の弾性があることが好ましい。こ のため針状部材710は樹脂、ゴム、柔らかい金属等の 材料で構成する。

【0092】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド2が流動体を基板に引出するとわずかかがら針出す 向の鉄差を含みながらバターン形成領域上に着弾する。 そのため着弾位置はほぼパターン形成領域の延在方向に 沿いながらもその境界がパターン形成領域からはみ出す 部分がある。処理装置310は、このようにはみ出した 流動体12をパターン形成領域の境界に沿って擦ってい くので、はみ出した部分がパターン形成領域内に戻さ れ、一定の幅のパターン15が形成される。

【0093】本実施形態7によれば、インクジェット式 40 記録ヘッド2から叶出された流動体の海道の養殖位置が ずれていても、その後に処理装置310がパターンを整 形していくので、勢ったパターンが形成できる。 【0094】 (実施形態8) 本発明の実施形態8は物理 的作用として着弾された流動体のうち遏制分を吸収する

処理に関し、主に上記第2の配置において用いられる。 【0095】図12に本実施形態8の処理概念の説明図 である。(a) は平面図、(b) は側面図を示す。本実 施形態8の処理装置311は、パターン形成領域に沿っ 能に構成された吸収部材711を備えている。吸収部材 711としては、過剰な流動体を吸収可能なバイブ形状 をしていることが好ましい。この吸い取った流動体を再 びインクジェット式記録ヘッド2から吐出可能に構成し てもよい。吸収部材711は、一定の機械的強度がある 一方、基板に損傷を与えない程度の確性があることが好 ましい。このため針状部材は樹脂、ゴム、柔らかい金属 等の材料で構成する。

【0096】インクジェット式記録ヘッド2からは若干 10 過剰に流動体を吐出した方がパターンの分断が生じにく い。しかし満剰な流動体の液滴が着降すると必要なパタ 一ン形成領域外に広がる。本実施形態では流動体の液滴 が基板に着弾された直後に処理装置311の吸収部材7 11が過剰な流動体を吸収していくことになる。このた めパターン形成領域以外に流動体が広がることがない。 また吸収した流動体を再びインクジェット式記録ヘッド 2に供給すれば流動体材料を節減することができる。 【0097】 (実施形態9) 本発明の実施形態9は物理 的作用として時間整で流動体を吐出する処理に関し、主 20 に上配第1の配置および第2の配置において用いられ

【0098】図13に本実施形態9の処理概念を説明す る側面図を示す。本実施影態9は、処理装置としても流 動体を吐出可能に構成されたインクジェット式記録へっ ド2を備えている。すなわち間 - の流動体を吐出するイ ンクジェット式記録ヘッド2が所定の距離をおいて配情 され、相前後して同一のパターン形成備並に流動体を叶 出可能に構成されている。

【0099】上記構成において先行するインクジェット 30 式配録ヘッド2 a は、若干の関隔をおいて流動体の着弾 騎12aがパターン形成領域上に配置されるように液維 11 a を吐出する。後続するインクジェット式距録ヘッ ド2bでは、既に着弾している流動体12aと合わせて パターン形成領域が流動体で満たされる程度の景に襲整 して流動体の液滴12bを吐出する。先に着弾した流動 体12aには表面張力が作用しており、後から着弾する 流動体12 bにも表面張力が作用する。表面張力が作用 している液滴上に他の液滴が落ちると、表面張力故に瞬 時に二つの被摘が混ざらず、後から落ちた被摘は先に着 弾した液滅上を潜ってその周辺に蒸ちる。 したがって木 実施形態では先に所定の間隔をおいて流動体12点が著 弾しているため、後から吐出された流動体の液溢11b は、先に着弾した流動体12aの存在しない領域に着弾 する。このためパターン形成領域には隙間なく成動体が 着弾し、その密度も一定になる。

【0100】なお、上記形態は、インクジェット式記録 ヘッド2を一個のみ設け、同一のパターン形成領域を往 復可能に制御回路5を構成してもよい。時間差で流動体 が吐出される点で同一の効果が得られるからである。こ て移動し基板1に着弾した流動体12の過剰分を吸収可 50 の場合、ヘッドの個数を削減できるという効果を奏す

۵. 【0101】本実施形態9によれば、時間差で同一の流 動体を吐出するので、基板に着弾する流動体の密度を均 一することができ、均一な輝みのパターンを形成でき

【0102】 (実施形態10) 本発明の実施形態10は 化学的作用としてレーザ照射により被適の濃度を上げる 処理に関し、主に上配第3の配置において用いられる。 【0103】図14に本実施形態10の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態10において処理装置3 10 20は第3の配置を採り、インクジェット式記録ヘッド 2から吐出される流動体の波滴11の側面からこの液滴 にレーザ光720を照射可能に構成されている。すなわ ち処理装置320はレーザ光を照射するために図示した いレーザ発光用ダイオード、レンズおよびアクチュエー タを備える。レーザ発光用ダイオードはエネルギー搬と して所定の短波長のレーザ光を発光し、レンズはこのレ ーザ光を波滴上に集光可能に構成される。アクチュエー タは彼滴11に正しくレーザ光720が焦点を結ぶよう にレンズおよびレーザ発光用ダイオー・ドの位置補正を行 20 うことが可能に構成されている。

【0104】なお、瞬時にエネルギーを与える手段とし てはレーザ光の照射が好ましいが、エネルギーを液滴に 供給可能であればこれに限定されるものではなく、熱風 供給、ランプ照射、雰囲気提供等が縮々の構成を適用で きる。

【0105】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド2から流動体の液滴11が吐出されると、所定依備 で処理装置320から射出されたレーザ光720が波滴 11上で焦点を結ぶ。これにより液滴11には高いエネ ルギーが瞬時に与えられる。エネルギーが与えられた被 滴11は温度が上昇するため流動体に溶解している物質 の濃度が上がったり、含有されている闕形分の成験化が 促進されたりする。そして著弾するまでに不要な溶媒成 分が減少し、バターン形成に必要な最小限の組成で落板 1上に着弾する。したがってインクジェット式配録ヘッ ドから吐出させるのに要求される流動体の粘度がバター ン形成に適当な流動体の粘度より低い場合でも、パター ン形成に適当な流動体の濃度に濃縮することができる。 【0106】本実施形能10によれば、インクジェット 式記録ヘッド2から吐出された液滴11が着端するまで で不要な溶媒成分を除去できるので、基板に着弾する流 動体が過剰に広がるのを防止でき、またパターン形成ま での時間を短くできる。

【0107】 (実施形態11) 本発明の実施形態11は 物理的作用として流動体の波譜に他の波滴を衝突させて 軌道を曲げる処理に関し、主に上記第3の配置において 用いられる。

【0108】図15に本実施形態11の処理概念を説明

21は第3の配置を採り、パターン形成領域の延在方向 に垂直な方向であって、インクジェット式記録ヘッド2 を中心として対向するように配置される。各処理装置3 21は異なる方向から波識にエネルギーを供給可能に印 加できる構成を備える。エネルギーとして所定の液滴を 衝突させるという力学的エネルギーを加える場合には 所定の被摘を吐出可能な構成、例えばインクジェット式 記録ヘッド2と同様な構成を備える。所定の液藻とは後 述する化学反応を目的とする場合はその反応を起こさせ る反応欲、反応を起こさせたくない場合にはインクジェ ット式記録ヘッド2が吐出するものと同一の流動体を吐 出させる。エネルギーとして空気を用いる場合には、空 気を吹き付けるためのコンプレッサおよびノズル等を備 える。エネルギーとして電界を用いる場合には、流動体 の波滴11の軌道を挟んで両側に電極を設け、両電極間 に電圧を印加する電源を備える。電界を用いる場合、イ ンクジェット式記録ヘッド2から吐出される流動体の彼 滴11を正または負に搭電させる構成も設ける。 【0109】上記構成においてインクジェット式記録へ

ッド2から流動体の液滴11が吐出されると、側海回路 5は処理装置321に制御信号Spを供給して、予め指 定されたパターン領域に流動体が着弾するよう制御す る。処理装置321が所定の被譲を吐出する場合には、 インクジェット式記録ヘッド2からの液漉110叶出に 同期して処理装置321から液滴が吐出され、其板に着 弾する前に両者が衝突し、液潤の着弾位置が変更され る。処理装置321が空気を噴出する場合にはインクジ エット式記録ヘッド2からの液滴の吐出に周期して空気 が吹き出され、流動体の液滴の軌道が曲げられる。処理 装置321が電界を印加する場合には、まずインクジェ ット式記録ヘッド2からの波滴11を帯電させ、両電極 間における電界の向きおよびその大きさを削御信号Sp によって調整すれば、陽極方向または陰極方向のいずれ かの方向に任意の変位だけ液滴の着弾位器を変更させる ことができる。

【0110】上記構成によれば、任意のパターン幅でパ ターン形成が行える。例えば図15に示すように、バタ 一ン幅が最も狭い領域A1では樹御信号Spの供給を禁 止するので、流動体の液滴11の着弾位置は一定し、最 も細いパターンが描ける。一方パターン幅を広くする面 城A2では複数の処理装置321に制御信号Spを交互 に供給する。制御信号Spが供給されると制御信号の最 に応じて、波滴の着弾位置が変動する。例えば緩御回路 321 aに制御信号を加えるとエネルギー721 aが供 給され位置P1に着弾する。制御回路321bに剛御信 号を加えるとエネルギー721bが供給され位置P2に 着弾する。インクジェット式記録ヘッド2に供給する振 御信号Shに同期させて制御信号Spを削御回路321g と3216とに交互に供給すれば、被流11が計出され する側面図を示す。本実施形態11において処理装置3 50 るごとに着弾位置が変化する。その結果として着弾した 場合の直径よりも広い幅のパターン形成領域に流動体を 充填させることができる。

【0111】本実施形態11によれば、制御回路321 が出力するエネルギーを制御することで任意のパターン 幅でパターンを形成することができる。

[0112] (実施形態12) 本発明の実施形態12は 物理化学的作用として流動体の機構に反応被の披露を衝 突させて化学反応を促進する処理に関し、主に上記第3 の配置において用いられる。

[0113] 図16に本来矩形形12の処理概念を説明 1 名領価部を示す。本実施形態12において処理装置 3 2 2は第3の配置を模り、インクジェント式配除ヘッド 2 から時間された影響に空中で反応被72 2 を総合可能に情報させる。数型整置32 2 12 を接合可能に出するために、例えばインクジェット定配験ヘッド 2 た同様な情点を備える。処理後置32 2 から反応被72 2の採置は、インクジェット定記録ヘッド 2 からの接近は、インクジェット定記録へのド2 からの接近は、イングジェット定記録へのド2 からの接近 1 1 の興温となるべく流い角度になるように調整される。角度が決りませ、両機需が接続可能となる時間が長くなるからである。制御国路ではインクジェットに記録って、人工に供給する時間が投入した。日本のよりによりに対しませた。

【0114】上記構成におかてインクジェット式配給へ ッド2から流動体の液薄11が吐出されると、ほぼ同時 に反応液722が処理装置322から吐出される。 两者 は基板1に到達する前に接触し化学反応等を生じ、反応 中または反応後に基備11差縮する。

[0115] 水炭鉱形態 2 に上れば、空中に反応を生じさせることができるので、社団時に対反応していては 図るが着弾時には反応していることが望ましい場合に適 3 により権水に変形して適用することがが極めてある。する。例えば反反すると同化が始まったり裏食性が発生したりする場合に適用できる。

【0116】(実施形態13)本発明の実施形態13は 流動体の被消の検出と補正処理に関し、主に上配第3の 配置において用いられる。

にはそのずれを補償するようにインクジェット式記録へ ッド2の流動体吐出を認御する制御信号Shのタイミン グを補正する。位置や方向がずれている場合には液藻の 着弾位置がずれてしまうので、このずれを補償するよう にモータM1に対する駆動信号SxまたはモータM2に 対する駆動信号 Syを供給する。これにより基板 1 に対 するインクジェット式記録ヘッド2の相対位置が補正さ れ、流動体をパターン形成領域に沿って適正な位置に着 弾させることができる。液滴の速度の検出は、検出信号 Sp2中のパルスの幅に応じて計算する。すなわちフォト デテクタの検出面積が決まっているので、液滴の通渦に よるパルスの幅が小さければ速度が早く、パルスの幅が 大きければ速度が遅いと考えられる。これらは線形的に 対応する。被請の速度が基準よりずれた場合、基準時よ り早くまたは遅く液滴が基板に着弾することになる。こ のずれを補償するために、制御回路5はY軸方向の相対 位置を誘整すべくモータM2に制御信号Syを供給す る。的的の大きさの検出は、検出信号Sp2のパルスの振 幅から検出する。接摘の径が大きければ光を遮る而積が 大きいので、検出信号中のレベル変動も大きくなるから である。液藻の大きさが許容値よりもずれた掛合、適正 な着弾が担保できなくなるので、制御回路5はヘッドの クリーニングをしたり警報を出力したりする措置をす

【0118】本実施形態13によればインクジェット式 記録ペッドからの液滴の弾道を検出して補正するので、 ヘッドを長時間使用して特性変化が生じた場合やヘッド に癖がある場合でも正確なパターン形成が可能である。 【0119】 (その他の変形例) 本発明は上記実施形態 なわちインクジェット式記録ヘッドから流動体を明出す る他に、その吐出前やその吐出後に、または基板に被滴 が着弾する前に処理を行うものであれば、本発明の思想 の範囲に入る。例えば上記各家族形態ではパターン形成 を目的としていたが、これに抑るものではたい、 丁葉的 用途であると民生的用途であるとを問わず、インクジェ ット式記録ヘッド等からインクを吐出して特定の効果を 得るものであれば種々に適用することが可能である。 【0120】また、上記各実施形態は独立に適用しても 複数を同時に適用してもよい。特にパターン形成が複数 工程によって完了する場合には、複数の処理装置により 処理することは好ましい。例えば、液滴吐出前に表面改 質を第1の配置の処理基置により行って海流を基板に終 着し易くし、吐出された流動体の液滴の氮性を検出しそ の位置補正を行う処理を第3の配置の処理装置で行い、

う等が考えられる。 【0121】

特性変化を樹樹信号にフィードパック可能に構成され る。例えば、吐出タイミングが基準よりずれている場合 50 される前に処理可能に構成したので、インクジェット方

最後に基板上の被纏の邊縮を第2の配置の処理装置で行

23 式を利用したバターン形成を崩処理により促進可能である。したがって、大がかりな工場設備を利用することなく、安価に基板に任意のパターンを形成することができ

【0122】本発明によれば、基板上に変動体が吐出された後に処理可能に構成したので、インクジェット方式 を利用してベクーン形成を後処理により促進可能である。したがって、大がかりな工権設備を利用することなく、安価に基板に任意のパターンを形成することができ

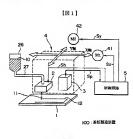
【0123】本発明によれば、流動体が吐出された瞬間 に処理可能に構成したので、空中で披露を反応させたり エネルギーを加えたりできる。したがつて、大がかりな 工様設備を利用することなく、安値に基板に任意のパタ ーンを形成することができる。

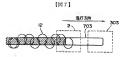
【図添の簡単な説明】

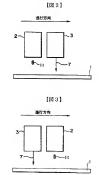
【図1】本発明の実施形態における基板製造装置の構成 図である。

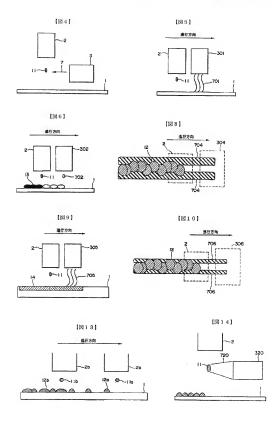
- 【図2】第1の配置(前処理)の説明図である。
- 【図3】第2の配数(後処理)の説明図である。
- 【図 4】第3の配置(吐出直後処理)の説明図である。 【図 5】実施形態1の処理概念を示す側面図である。
- 【図6】実施形能2の処理概念を示す側面図である。
- 【図7】実施彩館3の処理概念を示す平面図である。
- 【図8】実施形像4の処理概念を示す平面図である。
- 【図9】実施形態5の処理概念を示す側面図である。

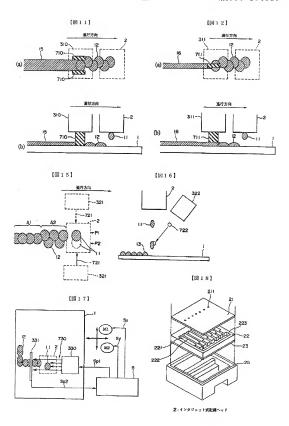
- 【図10】実施形態6の処理概念を示す平面図である。 【図11】実施形態7の処理概念を示す図であり、
- (a) は平面図、(b) は側面図である。
- 【図12】実施形態8の処理概念を示す図であり、
- (a) は平面図、(b) は側面図である。 【図13】実施形能9の処理概念を示す傾面図である。
- 【図14】実施形態10の処理概念を示す側面図である。 【図14】実施形態10の処理概念を示す側面図であ
- 【図15】実施形能11の処理概念を示す平面図であ 10 る。
- 【図16】実施形態12の処理概念を示す平面図であ
 - る。 【図17】実施形態13の処理概念図である。
 - 【図18】インクジェット式記録ヘットの分解斜視図で ある。
 - 【図19】インクジェット式記録ヘッドの主要部の斜視 図一部断前以である。
 - 【図20】インクジェット式記録ヘッドの吐出原理説明 図である。
- 20 【符号の説明】
 - 1…基板
 - 2…インクジェット式記録ヘッド
 - 3、301~330…処理装置
 - 4…駆動手段
 - 5…制御回路 7、701~730…処理の内容



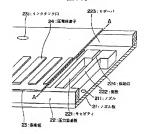




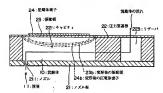




[219]



[图20]



フロントページの続き

(72)発明者 機橋 聡 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイ:エ ーエプソン株式会社内